## 科学研究費補助金研究成果報告書

平成 21年 5月 27日現在

研究種目:若手研究(B)
研究期間:2007~2008
課題番号:19760470
研究課題名(和文)
ビスマス層状構造強誘電体を用いた非鉛セラミックレゾネータの実用化に関する開発研究
研究課題名(英文)
Development and research of lead-free ceramic resonator using bismuth
layer-structured ferroelectrics
研究代表者
永田 肇(NAGATA HAJIME)
東京理科大学・理工学部・電気電子情報工学科・助教)
研究者番号:70339117

研究成果の概要:

本研究は、セラミックレゾネータ応用に求められる性能を十分に満足する材料を、環境にやさしい非鉛系ビスマス層状構造強誘電体(BLSF)セラミックスを用いて開発しようとするものである。BLSF セラミックスの結晶方位を制御することより、セラミックレゾネータの温度安定性を向上させることが出来た。その結果、レゾネータ応用に求められる基本的な性能を満足する非鉛 BLSF セラミックスを得た。

交付額

(金額単位:円)

直接経費	間接経費	合 計
2, 100, 000	0	2, 100, 000
800,000	240,000	1,040,000
2, 900, 000	240,000	3, 140, 000
	直接経費 2,100,000 800,000 2,900,000	直接経費  間接経費    2,100,000  0    800,000  240,000    2,900,000  240,000

研究分野: 材料工学

科研費の分科・細目:無機材料・物性

キーワード:機能性セラミックス、非鉛圧電セラミックス、セラミックレゾネータ、機械品質 係数、共振周波数温度特性、ビスマス層状構造強誘電体

1. 研究開始当初の背景

近年、環境保全に対する意識の高まりを受け、 電子部品におけるPb, Hg, Cd, Cr<sup>6+</sup>などの有害 元素を排除する動きが欧州を中心として活発と なり、2006年7月1日から、特定有害物質使用 制限指令(RoHS指令)の施行が開始された。現 在、実用化されている圧電セラミックスの大部分 はPb系(PZT系)強誘電体セラミックスであり、多 量の酸化鉛(PbO)を含んでいる。現段階で、圧 電セラミックス中に含まれる鉛は、性能面の問題 (代替物質が無いこと)からRoHS指令の対象か ら除外されている(例外規定)。しかし、今後も鉛 系圧電セラミックスの使用延長が認められるかど うかは不透明であり、非鉛圧電材料の研究・開 発は必要不可欠かつ急務であると考えられる。

PZT系強誘電体セラミックスの圧電的諸特性 を全ての面で上回る非鉛圧電材料は見つかっ ていないものの、個々の非鉛圧電材料の特長を 強調させた圧電材料の開発を推進することで、 鉛系で実用化されているアプリケーションを一つ 一つ置き替えていくことは可能であると考えられ る。表題のビスマス層状構造強誘電体(BLSF)は、 鉛系圧電材料と較べて、電気機械結合係数kは 小さいものの、機械的品質係数Qmが大きいこと や、共振周波数の温度安定性が優れているなど の特長を有している。

圧電セラミックスを用いた共振器(レゾネータ) は、鉛系圧電セラミックスを用いてすでに実用化 されている。市場では比較的高価だが発振周波 数精度の極めて高い水晶発振器だけでなく、テ レビのリモコンなどに使用されている簡単で安価 なセラミック発振器が要求されている。セラミック レゾネータ応用において、圧電素子はコルピッ ツ発振回路などのインダクタンス(L)成分として利 用されるため、大きな電気機械結合係数や圧電 定数よりも、機械的・電気的品質係数などの性 能が重要視される。上述の BLSF セラミックスの 特長を活かすことで、これらの性能をクリアできる 可能性は高いと考えられる。前出の RoHS 指令 は、4 年に一度の見直しがあり、圧電デバイス応 用の中でも共振子への応用は例外規定からは ずされる可能性が高いと指摘されている。このよ うな状況に鑑み、非鉛セラミックスレゾネータの 実用化に向けた検討は、必要かつ急務であると 考えられる。

2. 研究の目的

本研究は、レゾネータ応用に求められる性 能を十分に満足するセラミックレゾネータ材料 を、非鉛系 BLSF セラミックスを用いて開発しよ うとするものである。レゾネータの発振安定性 や高い発振周波数精度、さらには温度安定性 を実現するための具体的な目標としては、以 下に示した点が挙げられる。

- A. 大きな機械品質係数Q<sub>m</sub> (>2000)
- B. 大きな電気的品質係数Q<sub>emax</sub> (>30)
  (Q<sub>emax</sub> =tan θ<sub>max</sub>, θ<sub>max</sub>: インダクタンス領域の位相θの最大値)
- C. 小さな共振周波数温度係数 *TC-f* (<±30 ppm/<sup>o</sup>C)

これらの目標に対し、様々なBLSFセラミックス を作製し、BLSF特有の結晶構造や欠陥構造 に起因する特性変化(*Q<sub>m</sub>や TC-fへの影響*)を 明らかにする。例えば、高*Q<sub>m</sub>*化、高*Q<sub>e</sub>*化に対 しては、Vなどの添加物効果を検討し、低*TC-f* に対しては、結晶方位制御を検討する。これ により得られた新たな材料設計の指針を基に、 実用化に耐えうる非鉛BLSF系セラミックスを作 製する。

3. 研究の方法

本実験で作製したBLSFセラミックスは、Fig.1 に示したSr-Bi-Nb-Ti-O系であり、一般式で示 すと (Sr<sub>m-3+x</sub>, Bi<sub>4-x</sub>)(Ti<sub>m-x</sub>, Nb<sub>x</sub>)O<sub>3m+3</sub>である。ここ でmはBLSF中に含まれる酸素八面体数である。 m=2の右のエンドメンバーはSrBi<sub>2</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>9</sub> (SBN)で、m=3の左のエンドメンバーはBi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> (BIT)である。本報告では、SBNにVを添加した SrBi<sub>2</sub>Nb<sub>1.95</sub>V<sub>0.05</sub>O<sub>9</sub> (SBNV-0.05)について示す。



Fig. 1 Phase relation for Sr-Bi-Nb-Ti-O based  $\Re$  BLSF system (*m*=2-5).

普通焼成試料(Ordinary firing: OF)は通常の 固相反応法により作製した。出発原料はBi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SrCO<sub>3</sub>, Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>の純度 99.9 %以上の原料 を使用した。これらの原料をボールミルにより混 合し、800-850 ℃ で 2 時間仮焼成をした。その 後、粉砕し冷間等方加圧法(CIP)を用いて 150 MPaの圧力を5分間加えた後、950-1150 ℃で 2 時間の本焼成を行った。

粒子配向試料の作製はHot-Forging (HF)法 [3]を用いて6時間の本焼成を行い、焼成中に4 時間の加圧を行った(最大加圧 50 kg/cm<sup>2</sup>)。HF 法とは試料焼成中に一軸性の圧力を加えて圧 縮成形させるホット・ワーキング法の一種である。 BLSFにHF法を適用すると、BLSFのc面のすべ りが起こり、最終的には圧力を加えた方向にc軸 が揃った粒子配向型セラミックスが得られる。

得られた試料は、X線回折により酸素八面体 の数を表す層数m = 2のビスマス層状構造単一 相であることを確認し格子定数を決定した。電気 的諸特性測定には相対密度が 95 %以上の試 料を使用し、抵抗率、誘電温度特性、圧電特性 などの電気的諸特性の評価を通常の測定方法 で行った。強誘電体セラミックスに圧電性を付与 するための分極処理は、印加電界 E<sub>p</sub>=5-10 kV/mm、温度T<sub>p</sub>=150-200°Cおよび時間t<sub>p</sub>=5-10 minの条件で行った。圧電特性はEMAS標準規格 に基づき、インピーダンスアナライザー(HP4294A) を用いて、共振---反共振法で測定した。電気的品 質係数Qemaxは、共振周波数frと反共振周波数faの 間、すなわちインダクタンス領域における最大位相 角 $\theta_{max}$ の正接(tangent)をとることにより求めた。共 振および反共振周波数fの温度特性は、恒温槽 (TABAI-ESPEC SU-240)で温度制御を行い、温 度範囲は-25~125℃で測定した。温度係数 (TC-f)は以下の式(1)を用いて算出した。

$$TC - f = \frac{f_{r[125^{\circ}C]} - f_{r[-25^{\circ}C]}}{f_{r[20^{\circ}C]} \times T}$$
(1)

f[]はそれぞれの温度での共振あるいは反共振周波数、Tは温度変化幅(150°C)を示す。



Fig. 2 Frequency characteristics of impedance, *Z*, of OF SBNV-0.05 ceramic.



Fig. 3 Temperature dependences of the resonant frequency shift in some vibration (31), (31), (15) and (t) modes for OF SBNV-0.05 ceramic.

vi	Table bration	$1 Q_{\rm m}$ , $Q_{\rm m}$	Q <sub>emax</sub> and ∣ <i>T</i> ¢ for OF SBN	<i>C-f<sub>r∣</sub></i> of some V-0.05 cera	e mic.	
_	mode	$Q_{\rm m}$	$Q_{\rm emax}$  TC	- <i>f<sub>r</sub></i>   (ppm/°C	<u>C)</u>	
	33	5500	27.7	42.1		<i>c</i> -axis
	31	7100	2.90	46.0		Fig. 4 Crystal structure of SBNV and specimens
	15	5700	15.3	67.0		for each vibration mode.
	+	3000	23.5	25.2		
	(.	33)-mod	e		(31), (3	2)-mode (15), (24)-mode
Resonance frequency shift (%)	0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8  T -1.0	$C-f_r = 10$	• 33 mode (( • 33 mode () • 35 ppm/°C	(*)    0.4      (*)    0.2      HF)    10.2      **    0.0      **    0.0      **    -0.4      0.0    -0.4      0.0    -0.4      0.0    -0.6      0.0    -1.0		• 31 mode (OF) • 31 mode (HF) • 32 mode (HF) • 32 mode (HF) • 5.0 ppm/°C • • 15 mode (OF) • 15 mode (HF) • 15 mode (HF)
	-50	0 Temp	50 100 erature (°C)	150 -	50 0 Ter	50      100      150      -50      0      50      100      150        nperature (°C)      Temperature (°C)

Fig. 5 Temperature dependences of the resonant frequency shift in each vibration mode for OF and HF SBNV-0.05 ceramic.

4. 研究成果

Fig. 3 に各振動モードにおける共振周波数fr

## 4-1. 普通焼成試料(OF)の圧電諸特性

950°Cで焼成したSBNVセラミックスは、X線回 折測定よりm=2のBLSF単一相であることを確認 した。X線回折結果から求めた理論密度 $\rho_x$ と実 測密度 $\rho_o$ から、得られた試料の相対密度 $\rho_o/\rho_x$ は 97%であった。また、室温付近の抵抗率 $\rho$ は、  $10^{12} \Omega$ ·cm以上を示し、良好な絶縁性を持つこと がわかった。

Fig. 2 に、SBNVの(33)モードにおけるインピ ーダンス共振周波数特性を示す。十分に位相 が反転した良好な共振一反共振波形を示して いることがわかる。このとき、電気機械結合係数 はk<sub>33</sub>=0.17、QmおよびQemax</sub>はそれぞれ 5500, 28 となり、それぞれは圧電セラミックレゾネータとし て応用するのに十分大きな値を示した。このよう な良好な共振-反共振波形が得られた原因とし てVイオンの添加が挙げられる。V添加により焼 成温度を低下することが出来たため、Biイオン の揮発に伴う酸素空孔が減少し、ドメイン反転を 容易にしたものと考えられる。本研究で実施した 他のBLSFセラミックス(Fig. 1)においてもV添加 に良好なより同様な傾向を示すことが明らかとな った。



の温度に対する周波数シフトを示す。全ての振動モードにおいて、温度の上昇とともにfrは直線的に減少しており、1次の温度依存性を持つことがわかる。これらの傾きから求めた|TC-f/は、(33)および(t)モードにおいて 42.1 および 25.2 ppm/°Cと良好な値を示した。これらの各振動モードにおける|TC-flと、QmおよびQeをTable 1 にまとめた。いずれの振動モードにおいても、大きなQmを示し、比較的小さな|TC-flを持つことが分かった。しかし、TC-fに対する厳しい要求を満たすには更なる改善が必要である。

## 4-2. 粒子配向試料(HF)の圧電諸特性

HF 法により作製した配向試料の X 線回折パ ターンより、Lotgering 法を用いて計算した配向 度 F は、ほぼ 100%であった。

Fig.4にSBNの結晶構造とHF試料における各 振動モードの形状の関係を示す。OF試料の (31)および(15)モードは粒子配向することで(31) と(32)および(15)と(24)モードにそれぞれ区別さ れる。Table 2 に各振動モードにおける圧電特性 を示す。HFを施した試料では、特に、(33)およ び(15)モードにおいて、k33=0.31 およびk15=0.16 と、普通焼成(OF)のものと比較して 1.5~2 倍程 度大きな値を示した。 Qemax はそれぞれ 66((33) モ ード)、22((15)モード)であり、それぞれのOF試料 の28、15と比べて大幅に改善した。Qmはそれぞ れ 2200((33)モード)、4600((15)モード)であり、そ れぞれのOF試料の 5500、5700 と比べて低下し たものの、レゾネータ用材料として応用するには 十分な値を示した。これらは、粒子配向によりド メインが反転しやすくなったことが要因と考えら れる。

Fig. 5 に、各振動モードにおける共振周波数 の温度特性を示す。HF試料では、(33)、(31)お よび(15)モードの|TC-f,|が、それぞれ、16.5、5.0 および 27.0 ppm/°Cとなり、OF試料の 42.1、46.0 および 67.8 ppm/°Cと比べて大幅に改善すること がわかった。

ここで、粒子配向による|TC-f|値の変化について考察する。例えば、(31)モードの共振周波数 f は(2)式で示される。

$$f = \frac{1}{2x} \sqrt{\frac{1}{\rho \times s_{11}^{E}}} \quad (2)$$

振動長x、密度pは-25~125°Cの範囲ではほとん ど変化しないことが確認されており、fの温度変 化(|TC-f|)は、主として弾性定数 $s_{11}^{E}$ の温度特性 に大きく依存すると考えられる。同様に、(33)、 (32)、(15)および(24)モードの|TC-f|は、それぞれ  $s_{33}^{E}$ 、 $s_{22}^{E}$ 、 $s_{55}^{E}$ および $s_{44}^{E}$ に依存すると考えられる。 Table 2 に各振動モードにおける $|TC-f_{1}|$ および $s^{E}$ を示す。 $s^{E}$ の小さい振動モードにおいて $|TC-f_{1}|$ が 小さくなることがわかった。 $|TC-f_{1}|$ が大きくなった (32)および(24)モードはBi2O2層を介した振動モ ードである。Bi2O2層のBiイオンと酸素八面体の Oイオンの結合性は他のイオン同士の結合性よ りも弱いことが報告されている。そのため、(32)お よび(24)モードでは弾性定数sが大きくなり、 |TC-f<sub>l</sub>が大きくなることが推測できる。一方、HF を施した(33)、(31)および(15)モードは結晶構造 に対してab軸方向の振動であり、OF試料の(33)、 (31)および(15)モードよりもBi<sub>2</sub>O<sub>2</sub>層の影響が少 ないため、sが小さくなり、|TC-f,/が改善されると 推測できる。さらに、(33)モードの配向度Fに対 する $s_{33}^{E}$ および|TC- $f_r$ /の関係を調べると、Fが大き くなるにつれて、すなわち、振動方向にab軸成 分が増加するにつれて、s33<sup>E</sup>が小さくなり、|TC-f| は改善される。これらのことから、結晶構造の異 方性が大きいBLSFは共振周波数の温度特性が 結晶構造の異方性と深く関係していることが示 唆された。

共振周波数温度特性に対して結晶構造異方 性が強く寄与する傾向は、SBNV セラミックスの みならず、本研究で実施した他の BLSF セラミッ クス(Fig. 1)においても同様な傾向を示すことが 明らかとなった。すなわち、弾性コンプライアンス 定数 *s* が小さくなる振動モードにおいて、小さな *TC-f* が得られることが明らかとなった。

Table 2 Piezoelectric properties of each vibration mode for OF and HF SBNV-0.05 ceramic.

mode	k (%)	$Q_{\rm m}$	$Q_{e}$	
33(OF)	0.17	5500	27.7	
33(HF)	0.31	2200	66.0	
31(OF)	0.04	7100	2.9	
<b>31(HF)</b>	0.01	-	-	
32(HF)	0.05	9300	5.7	
15(OF)	0.11	5700	15.3	
15(HF)	0.16	4600	21.6	
24(HF)	0.10	7200	1 <b>4.</b> 7	

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計20件)

- 永田肇、晝間裕二、鈴木宗泰、竹中正「高 い機械的品質係数を持つビスマス層状構 造強誘電体セラミックス」電気学会論文 誌C(電子・情報・システム部門誌)127-C No.8(2007) pp.1141-1146(査読有).
- (2) <u>Hajime Nagata</u>, Kenji Matsumoto, Tadayuki Hirosue, Yuji Hiruma, and Tadashi Takenaka, "Fabrication and Electrical Properties of Potassium Niobate Ferroelectric Ceramics",

Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 46, No. 10B (2007) pp. 7084-7088 (査読有).

- ③ T. Takenaka, <u>H. Nagata</u>, Y. Hiruma, Y. Yoshii and K. Matumoto, "Lead-free piezoelectric ceramics based on perovskite structures", *Journal of Electroceramics*, Vol. 19, (2007) pp. 259-265 (査読有).
- ④ M. Suzuki, S. Inai, T. Tokutsu, <u>H. Nagata</u> and T. Takenaka, "Ferroelectric property of Bi<sub>3</sub>TiTaO<sub>9</sub> based ceramics with Nd substitution", *Ferroelectrics*, 356 (2007) pp. 62-66 (査読有).
- K. Yoshii, Y. Hiruma, M. Suzuki, <u>H. Nagata</u> and T. Takenaka, "The piezoelectric properties of La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> doped (Bi<sub>1/2</sub>Na<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-(Bi<sub>1/2</sub>K<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub> ceramics", *Ferroelectrics*, 358 (2007) pp. 134-138 (査読有).
- ⑤ S. Inai, J. Sato, R. Aoyagi, Y. Hiruma, M. Suzuki, <u>H. Nagata</u> and T. Takenaka, "Piezoelectric Properties of V and Ba Substituted SrBi<sub>2</sub>Nb<sub>2</sub>O<sub>9</sub> Ceramics", *Ferroelectrics*, 358 (2007) pp. 148-152 (査 読有).
- ⑦ K. Matsumoto, Y. Hiruma, <u>H. Nagata</u> and T. Takenaka, "Piezoelectric Properties of KNbO<sub>3</sub> Ceramics prepared by Ordinary Sintering", *Ferroelectrics*, 358 (2007) pp. 169-174 (査読有).
- ⑧ Yuji Hiruma, <u>Hajime Nagata</u> and Tadashi Takenaka, "Phase Transition Temperatures and Piezoelectric Properties of (Bi<sub>1/2</sub>Na<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-(Bi<sub>1/2</sub>Li<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-(Bi<sub>1/2</sub>K<sub>1/2</sub>)Ti O<sub>3</sub>", IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, Vol. 54, No. 12 (2007) pp. 2393-2499 (査読有).
- ⑨ Y. Hiruma, Y. Imai, Y. Watanabe, <u>H. Nagata</u> and T. Takenaka, "Large electrostrain near the phase transition temperature of (Bi<sub>1/2</sub>Na<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-SrTiO<sub>3</sub> ferroelectric ceramics", Applied Physics Letters, Vol. 92, (2008) pp. 262904-1~3 (査読有).
- H. Nagata, S. Matsuzawa, T. Tokutsu, S. Inai, M. Suzuki, Y. Hiruma and T. Takenaka, " Temperature dependence of piezoelectric properties on Nd and V co-substituted Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> Ceramics for Ceramic Resonator Applications", *Ceramic International* Volume 35, Issue 1, January (2009), pp. 163–167 (査読有).
- Shinya Inai, Yuji Hiruma, Muneyasu Suzuki, <u>Hajime Nagata</u> and Tadashi Takenaka, " Temperature Dependences of Piezoelectric Properties of (Sr, Me)Bi<sub>2</sub>(Nb,V)<sub>2</sub>O<sub>9</sub> (Me=Ba, Ca, Bi<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>) Ceramics", *Ceramic International*, Vol. 34, 4 (2008) pp. 741-744 (査読有).
- 1 K. Matsumoto, Y. Hiruma, <u>H. Nagata</u> and T.

Takenaka, "Electric-field-induced Strain in Mn-doped KNbO<sub>3</sub> Ferroelectric Ceramics", *Ceramic International*, Vol. 34, 4 (2008) pp. 787-791(查読有).

- ① <u>H. NAGATA</u>, T. TOKUTSU, D. NAKAI, Y. HIRUMA, and T. TAKENAKA, "High Temperature Piezoelectric Properties of Vanadium doped Bi<sub>4</sub>Ti<sub>3</sub>O<sub>12</sub> Ceramics with Grain Orientation", *Ferroelectrics*, Volume 368, Issue 1, 2008, pp. 202 208 (査読有).
- Hajime Nagata, "Electrical properties and tracer diffusion of oxygen in some Bi-based lead-free piezoelectric ceramics", *Journal of the Ceramic Society of Japan*, 116[2] (2008) pp. 271-277 (査読有).
- (15) Tadashi Takenaka, <u>Hajime Nagata</u>, and Yuji Hiruma, "Current Developments and Prospective of Lead-Free Piezoelectric Ceramics", *Japanese Journal of Applied Physics*, 47 (2008) pp. 3787-3801 (査読有).
- (16) Masahiro Nemoto, Yuji Hiruma, <u>Hajime</u> <u>Nagata</u>, and Tadashi Takenaka, "Fabrication and Piezoelectric Properties of Grain-Oriented (Bi<sub>1/2</sub>K<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-BaTiO<sub>3</sub> Ceramics", *Japanese Journal of Applied Physics*, 47 (2008) pp. 3829-3832 (査読有).
- Yuji Hiruma, Hajime Nagata, and Tadashi Takenaka, "Phase diagrams and electrical properties of (Bi<sub>1/2</sub>Na<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-based solid solutions", *Journal of Applied Physics*, (2008) 104 124106 (査読有).
- Yuji Hiruma, Kazushige Yoshii, Hajime Nagata, and Tadashi Takenaka, "Phase transition temperature and electrical properties of (Bi<sub>1/2</sub>Na<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-(Bi<sub>1/2</sub>A<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub> (A=Li and K) lead-free ferroelectric ceramics", *Journal of Applied Physics*, (2008) 103 084121 (査読有).
- Yuji Hiruma, Hajime Nagata, and Tadashi Takenaka, "Thermal depoling process and piezoelectric properties of bismuth sodium titanate ceramics", *Journal of Applied Physics*, (2009) 105 084112 (査読有).
- Hajime Nagata, Tadayuki Hirosue, Kouhei Hikita, Yuji Hiruma, and Tadashi Takenaka, "Evaluation of Piezoelectric Properties for KNbO<sub>3</sub>-Based Ceramics", *Ferroelectrics*, 381:1–5, (2009) (査読有).

〔学会発表〕(計19件)

- <u>永田</u>肇、稲井慎也、中井大祐、得津統 司、晝間裕二、竹中 正:「粒子配向した ビスマス層状構造強誘電体セラミックスの 圧電温度特性」第36回 EMシンポジウム、 2007 年 5 月 17 日、東京
- ② <u>永田 肇</u>、松本研司、広末忠之、花神大樹、 晝間裕二、竹中 正:「KNbO<sub>3</sub>系強誘電体

セラミックスの作製プロセスと電気的諸特 性」第 24 回強誘電体応用会議、2007 年 5 月 23 日、京都

- (3) <u>H. Nagata</u>, T. Tokutsu, D. Nakai, Y. Hiuruma and T. Takenaka : "High Temperature Piezoelectric Properties of some Bismuth Layer-structured Ferroelectrics", *The 11<sup>th</sup> European Meeting on Ferroelectricity*, Sep 5, 2007, Bled, Slovenia.
- <u>永田 肇</u>、広末忠之、松本研司、晝間裕二、 竹中 正:「KNbO<sub>3</sub>系セラミックスにおける圧 電諸特性の経時変化」日本セラミックス協会 第 20 回秋季シンポジウム、2007 年 9 月 12 日、名古屋
- (5) 渡辺芳則、晝間裕二、<u>永田 肇</u>、竹中正 「(Bi<sub>1/2</sub>Na<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-BiAlO<sub>3</sub>系セラミックスの作 製と電気的諸特性」第 27 回エレクトロセラミ ックス研究討論会、2007 年 10 月 19 日、東 京.
- ⑥ M. Nemoto, Y. Hiruma, <u>H. Nagata</u> and T. Takenaka :「Fabrication and Piezoelectric Properties of Grain Oriented (Bi<sub>1/2</sub>K<sub>1/2</sub>)TiO<sub>3</sub>-BaTiO<sub>3</sub> Ceramics」第 28 回 超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム、2007 年 11 月 15 日、つくば
- ⑦ H. Nagata, T. Hirosue, Y. Hiruma and T. Takenaka : "Piezoelectric Properties of Potassium Niobate Based Ferroelectric Ceremics", Second Japan-Taiwan Workshop on Future Frequency Control Devices, Dec 5, 2007, Taipei, Taiwan.
- <u>永田 肇</u>、晝間裕二、竹中 正:「ビスマス 系無鉛圧電セラミックスの電気的特性と酸 素同位体拡散」日本セラミックス協会 2008 年年会、2008 年 3 月 22 日
- 9 今井能孝、渡辺芳則、晝間裕二、<u>永田 肇</u>、 竹中 正「(Bi<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub>-SrTiO<sub>3</sub>系非鉛強 誘電体セラミックスの相転移温度と巨大電 界誘起歪み」第 55 回応用物理学関係連合 講演会(2008 年春季)、2008 年 3 月 27 日、 千葉.
- (1) 渡部朋真、晝間裕二、永田 肇、竹中 正: 「(Bi<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub>系強誘電体セラミックスの 大振幅振動時におけるハイパワー特性」第 55 回応用物理学会関係連合講演会、2008 年3月27日、千葉.
- <u>永田 肇</u>、田端総一郎、広末忠之、晝間 裕二、竹中 正:「KNbO<sub>3</sub>系セラミックスの 圧電経時変化特性」第 37 回 EMシンポ ジウム、2008 年 5 月 8 日、東京
- ② 晝間裕二、渡部朋真、<u>永田</u>肇、竹中正: 「(Bi<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub>系非鉛強誘電体セラミックスのハイパワー特性」第25回強誘電体応用会議、2008年5月28日、京都
- (3) M. Nemoto, Y. Hiruma, <u>H. Nagata</u> and T. Takenaka : "Fabrication and Piezoelectric

- H. Nagata, T. Hirosue, K. Hikita, Y. Hiruma, and T. Takenaka : "Evaluation of Piezoelectric Properties for KNbO<sub>3</sub>-Based Ceramics", The 6th Asian Meeting on Ferroelectrics (AMF-6), August 5, 2008, Taipei, Taiwan
- (1) <u>H. Nagata</u>, T. Hirosue, Y. Hiruma, and T. Takenaka: "Piezoelectric aging behavior of high density KNbO<sub>3</sub>-based ceramics.", Electroceramics XI, Sep. 2008, Manchester, UK.
- (6) 得津統司、宮林宏和、晝間祐二、<u>永田 肇</u>、 竹中 正:「CaBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub>系セラミックスの電 気的諸特性と圧電温度特性」日本セラミック ス協会・第 21 回秋季シンポジウム、2008 年 9月17日、小倉
- T. Tokutsu, H. Miyabayashi, Y. Hiruma. <u>H. Nagata</u>, T. Takenaka : "Electrical Properties and Temperature Dependence of CaBi<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>9</sub>-Based Ceramics", AMEC6 & 28th Electronics Division Meeting, October 22, 2008, Tsukuba, Japan
- (1) <u>H. Nagata</u>, T. Tokutsu, H. Miyabayashi, Y. Hiruma, and T. Takenaka : "Piezoelectric Properties of Bismuth Layer-Structured Ferroelectric Ceramics with Wide Working Temperature", 3rd Japan-Taiwan Workshop on Future Frequency Control Devices, December 1-5, 2008, Taipei, Taiwan.
- <u>永田 肇</u>、渡部朋真、高井広大、晝間裕二、 竹中 正:「(Bi<sub>0.5</sub>Na<sub>0.5</sub>)TiO<sub>3</sub>系非鉛圧電セラ ミックスの大振幅特性における圧電諸特性」 圧電材料・デバイスシンポジウム2009、2009 年2月2日、仙台

〔図書〕(計1件)

 永田 肇(共著)「無鉛圧電セラミック ス・デバイス」pp. 43-61、日本 AEM 学界 編、養賢堂、2008 年 9 月

6.研究組織
 研究代表者
 永田 肇(NAGATA HAJIME)
 東京理科大学・理工学部・助教
 研究者番号:70339117

(2)研究分担者 なし

(3)連携研究者 なし